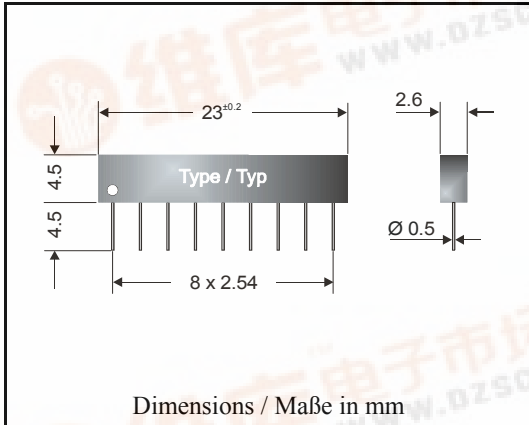


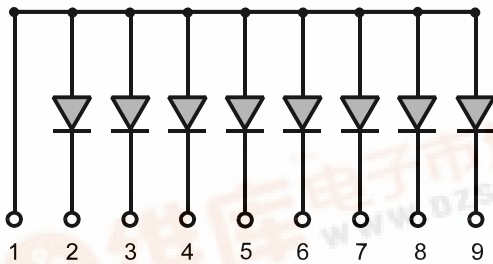
**DAF 811 A/K ... DAF 814 A/K (1.2 W)**

**Fast Switching Rectifier Arrays**

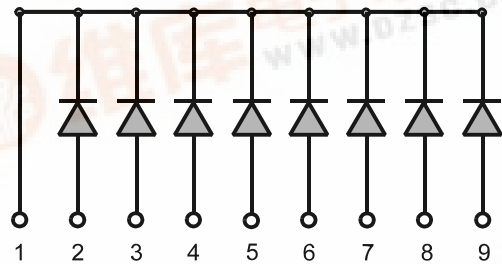
**Schnelle Gleichrichter Sätze**



Nominal power dissipation Nenn-Verlustleistung	1.2 W
Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzensperrspannung	100...400 V
9 Pin-Plastic case 9 Pin-Kunststoffgehäuse	23 x 2.6 x 4.5 [mm]
Weight approx. – Gewicht ca.	0.6 g
Standard packaging: bulk	see page 22
Standard Lieferform: lose im Karton	s. Seite 22



"DA 811 A...8110 A": com. anodes / gem. Anoden



"DA 811 K...8110 K": com. cathodes / gem. Kathoden

**Maximum ratings**

**Grenzwerte**

Type Typ	Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzensperrspannung $V_{RRM}$ [V]	Surge peak reverse voltage Stoßspitzensperrspannung $V_{RSM}$ [V]
DAF 811 A/K	100	120
DAF 814 A/K	400	480

Max. average forward rectified current, R-load,  
for one diode operation only  
per diode for simultaneous operation

$T_A = 25^\circ\text{C}$

$I_{FAV}$  600 mA <sup>1)</sup>  
 $I_{FAV}$  150 mA <sup>1)</sup>

Dauergrenzstrom in Einwegschtung mit R-Last,  
für eine einzelne Diode  
pro Diode bei gleichzeitigem Betrieb

$T_U = 25^\circ\text{C}$

$I_{FAV}$  600 mA <sup>1)</sup>  
 $I_{FAV}$  150 mA <sup>1)</sup>

Peak forward surge current, 50 Hz half sine-wave  
Stoßstrom für eine 50 Hz Sinus-Halbwellen

$T_A = 25^\circ\text{C}$

$I_{FSM}$  30 A

<sup>1)</sup> Leads kept at ambient temperature at a distance of 3 mm from case  
Anschlußdrähte in 3 mm Abstand von Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten



Max. power dissipation – Verlustleistung	$T_A = 25^\circ\text{C}$	$P_{\text{tot}}$	1.2 W <sup>1)</sup>
Operating junction temperature – Sperrschichttemperatur		$T_j$	- 50...+150°C
Storage temperature – Lagerungstemperatur		$T_S$	- 50...+150°C

**Characteristics**

**Kennwerte**

Forward voltage Durchlaßspannung	$T_j = 25^\circ\text{C}$	$I_F = 1\text{ A}$	$V_F$	< 1.3 V
Leakage current Sperrstrom	$T_j = 25^\circ\text{C}$ $T_j = 100^\circ\text{C}$	$V_R = V_{RRM}$ $V_R = V_{RRM}$	$I_R$ $I_R$	< 10 µA < 90 µA
Reverse recovery time Sperrverzug		$I_F = 10\text{ mA through/über}$ $I_R = 10\text{ mA to/auf } I_R = 1\text{ mA}$	$t_{rr}$	< 350 ns
Thermal resistance junction to ambient air Wärmewiderstand Sperrschicht – umgebende Luft			$R_{\text{thA}}$	< 85 K/W <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Leads kept at ambient temperature at a distance of 3 mm from case  
Anschlußdrähte in 3 mm Abstand von Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten